

オプティクス

レーザーラインフィルター

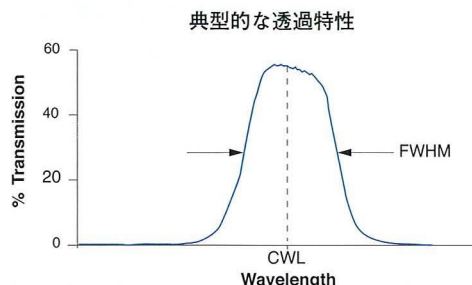
これらのバンドパスフィルターは、基本的には真空蒸着により作製されたファブリーペロー干渉フィルターで、特定波長帯域の光だけを透過し、帯域外の光を阻止します。

これらの反射多層膜は、高低2種の屈折率からなる物質で構成され、反射率は99.99%を超えることもあります。層の厚みや層の数を変更することにより、フィルターの中心波長および帯域を変更することができます。この種のフィルターは、パスバンドでは非常に高い透過率を示しますが、バンド外の光を阻止する性能は高くありません。この点を補正するために、そのバンド外で阻止効果を持つ誘電体または金属誘電体を追加します。この追加した成分に

より不要なバンド外の放射を阻止しますが、同時にフィルターの透過率を低下させます。

これらの方式を用い、当社では、340~1650nmの幅広い種類のバンドパスフィルターを提供しています。

特別注文品については、当社までお問合せください。

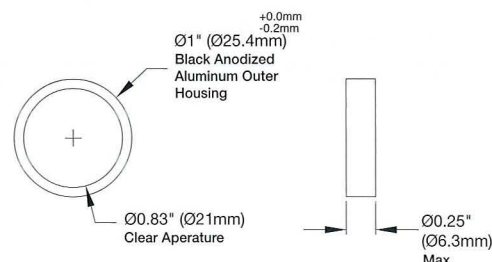


レーザーラインフィルター

型番	レーザーライン	中心波長 (nm)	半値全幅 (nm)	透過率 MIN (%)	ブロック効果: ≥OD4 MIN.	価格コード
FL350-10	XeF	350 ±2	10 ±2	25	200-1150nm	C
FL355-10	Nd:YAG	355 ±2	10 ±2	25	200-1150nm	C
FL441.6-10	HeCd	441.6 ±2	10 ±2	60	200-1150nm	C
FL457.9-10	アルゴン	457.9 ±2	10 ±2	65	200-1150nm	C
FL460-10	アルゴン	460 ±0.2	10 ±2	65	200-1150nm	C
FL488-1	アルゴン	488 ±0.2	1 ±0.2	40	200-1150nm	G
FL488-3	アルゴン	488 ±0.6	3 ±0.6	45	200-1150nm	F
FL488-10	アルゴン	488 ±2	10 ±2	65	200-1150nm	C
FL508.5-10	アルゴン	508.5 ±2	10 ±2	65	200-1150nm	C
FL514.5-1	アルゴン	514.5 ±0.2	1 ±0.2	45	200-1150nm	G
FL514.5-3	アルゴン	514.5 ±0.6	3 ±0.6	55	200-1150nm	F
FL514.5-10	アルゴン	514.5 ±2	10 ±2	65	200-1150nm	C
FL532.-1	アルゴン	532. ±0.2	1 ±0.2	40	200-1150nm	G
FL532-3	アルゴン	532 ±0.6	3 ±0.6	60	200-1150nm	F
FL532-10	Nd:YAG	532 ±2	10 ±2	70	200-1150nm	C
FL543.5-10	HeNe	543.5 ±2	10 ±2	70	200-1150nm	C
FL632.8-1	HeNe	632.8 ±0.2	1 ±0.2	50	200-1150nm	G
FL632.8-3	HeNe	632.8 ±0.6	3 ±0.6	65	200-1150nm	F
FL632.8-10	HeNe	632.8 ±2	10 ±2	70	200-1150nm	C
FL635-10	半導体	635 ±2	10 ±2	70	200-1150nm	C
FL647.1-10	クリプトン	647.1 ±2	10 ±2	70	200-1150nm	C
FL670-10	半導体	670 ±2	10 ±2	70	200-1150nm	C
FL694.3-10	ルビー	694.3 ±2	10 ±2	70	200-1150nm	C
FL730-10	半導体	730 ±2	10 ±2	70	200-1150nm	C
FL780-10	半導体	780 ±2	10 ±2	70	200-1150nm	C
FL830-10	半導体	830 ±2	10 ±2	70	200-1150nm	C
FL850-10	半導体	850 ±2	10 ±2	70	200-1150nm	C
FL880-10	半導体	880 ±2	10 ±2	70	200-1150nm	C
FL880-40	半導体	880 ±8	40 ±8	70	200-1150nm	C
FL880-70	半導体	880 ±10	70 ±8	70	200-1150nm	C
FL905-10	半導体	905 ±2	10 ±2	70	200-1150nm	C
FL905-25	半導体	905 ±5	25 ±5	70	200-1150nm	C
FL1064-3	Nd:YAG	1064 ±0.6	3 ±0.6	55	200-1150nm	G
FL1064-10	Nd:YAG	1064 ±2	10 ±2	70	200-1150nm	C
FL1152-10	HeNe	1152 ±2	10 ±2	45	200-3000nm	C
FL1300-30	半導体	1300 ±6	30 ±6	45	200-3000nm	C
FL1550-12	半導体	1550 ±2.5	12 ±2.3	40	200-1850nm	C
FL1550-30	半導体	1550 ±6	30 ±6	45	200-1850nm	C
FL1550-40	半導体	1550 ±8	40 ±8	45	200-1850nm	C

仕様

- 最小開口：直径 21mm (外径：1 インチ、下図参照)
- 厚さ：< 6.3mm
- 最適動作温度：23°C
- エッジ処理：黒色アルマイト加工リングにマウント
- エッジマーキング：CWL-FWHM ↑ ロット番号 (矢印は、光の透過方向を示す)
- 表面精度／コーティング品質：スクラッチ&ディグ 80-50 MIL-0-13830A に準拠
- 動作温度：-50°C ~ +80°C
- 基板：ショット製 テンパックスフロート® (Borofloat) およびソーダ石灰



価格コード	価格
A	¥ 13,152
B	¥ 13,472
C	¥ 14,176
D	¥ 15,312
E	¥ 20,304
F	¥ 20,768
G	¥ 31,808